

3CG114B 型 PNP 硅高频小功率晶体管

参数符号		测试条件	规范值	单位
极 限 值	P _{CM}	T _A =25℃	1.0	W
	I _{CM}		1.0	A
	T _{jm}		175	℃
	T _{stg}		-55~150	℃
直 流 参 数	V _{(BR)CBO}	I _{CB} =0.1mA	≥60	V
	V _{(BR)CEO}	I _{CE} =0.1mA	≥60	V
	V _{(BR)EBO}	I _{EB} =0.1mA	≥5.0	V
	I _{CBO}	V _{CB} =30V	≤1.0	μA
	I _{CEO}	V _{CE} =30V	≤1.0	μA
	V _{BEsat}	I _C =500mA	≤0.5	V
	V _{CEsat}	I _B =50mA	≤1.5	
	h _{FE}	V _{CE} =2V I _C =500mA	50~150	
外 引 线 说 明	 1. E 发射极 2. B 基 极 3. C 集电极 A3-02B(B4)			
替代型号：				